

主要半導体材料ガス等国内販売実績5年推移

(暦年:2010年~2014年)

一般社団法人 日本産業・医療ガス協会
特殊ガス企画委員会
単位:kg

番号	ガス名称	化学記号	2010年 (平成22年)		2011年 (平成23年)		2012年 (平成24年)		2013年 (平成25年)		2014年 (平成26年)	
			需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比
1	アールシ	AsH3	20,600	132%	16,400	80%	13,300	81%	10,800	81%	9,800	91%
2	ジボラン	B2H6	480	112%	540	113%	390	72%	680	174%	390	57%
3	三塩化ホウ素	BCl3	123,600	122%	120,700	98%	105,400	87%	102,900	98%	126,700	123%
4	四フッ化炭素	CF4	475,900	133%	494,900	104%	484,300	98%	500,600	103%	565,200	113%
5	三フッ化メタン	CHF3	86,100	117%	79,800	93%	78,300	98%	82,900	106%	84,900	102%
6	六フッ化エタン	C2F6	247,900	120%	227,300	92%	206,300	91%	175,500	85%	131,800	75%
7	八フッ化シクロブタン	C4F8	43,700	107%	48,200	110%	51,800	107%	56,100	108%	65,000	116%
8	塩素	Cl2	247,300	143%	347,800	141%	255,800	74%	274,000	107%	307,100	112%
9	ゲルマニ	GeH4	110	100%	240	218%	240	100%	240	100%	240	100%
10	臭化水素	HBr	94,300	126%	106,700	113%	95,000	89%	91,600	96%	125,400	137%
11	アンモニア	NH3	1,589,600	162%	2,488,200	157%	2,842,200	114%	2,919,000	103%	3,442,600	118%
12	三フッ化窒素	NF3	1,658,200	135%	1,637,600	99%	1,588,800	97%	1,694,200	107%	1,717,600	101%
13	一酸化二窒素	N2O	603,400	123%	593,400	98%	739,500	125%	951,300	129%	992,500	104%
14	ホスフィン	PH3	15,800	135%	12,400	78%	11,500	93%	8,000	70%	8,300	104%
15	モノシラン	SiH4	547,500	127%	541,900	99%	323,500	60%	373,700	116%	424,700	114%
16	ジシラン	Si2H6	580	105%	*1							
17	ジクロロシラン	SiH2Cl2	160,000	123%	172,900	108%	166,100	96%	256,300	154%	172,800	67%
18	四フッ化ケイ素	SiF4	5,700	95%	5,700	100%	6,000	105%	5,400	90%	5,400	100%
19	TEOS	(C2H5O)4Si	424,500	109%	407,700	96%	399,600	98%	380,800	95%	421,900	111%
20	六フッ化硫黄	SF6	267,400	144%	267,400	100%	243,000	91%	240,000	99%	211,000	88%
21	六フッ化タンゲステン	WF6	108,000	120%	103,000	95%	100,000	97%	95,000	95%	105,000	111%
22	有機金属		2,470	153%	2,780	113%	3,040	109%	2,250	74%	2,090	93%
23	その他ガス	H2Se BF3、Si2H6 SiHCl3等										
年間需要金額(単位:億円)			603	121%	612	101%	534	87%	522	98%	526	101%

(注) *1 ジシラン:2011年よりその他ガス欄に移行